



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿6丁目24番1号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20050913000C  
2007年11月20日

## お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部  
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎

### TI 台湾サイト HPA PowerPad製品のDie(チップ)接着材の変更のご案内 (525 認定品への追加認定 240 製品の連絡)

(第三版 PCN20050913000A 2007年5月19日発行)

(第二版 PCN20050913000 2006年9月12日発行、初版 PCN20050913000 2005年9月28日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

### 一 記 一

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design <input type="checkbox"/> Electrical <input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process <input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process <input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process <input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling <input type="checkbox"/> -
変更内容	下記変更について、525 認定品に加え 240 製品の追加認定の連絡になります。 TI 台湾サイト HPA PowerPad 製品の Die(チップ)接着材の変更 現行 : チップ接着剤 HN408x 変更後 : チップ接着剤 QMI529(熱伝導性の改善したもの)	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	12月下旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり
備考	--	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。  
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは[pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com)にお問い合わせ下さい。

以上

## 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

### 変更内容

内容：下記変更について、525 認定品に加え 240 製品の追加認定の連絡になります。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI(台湾)サイト製造一部パッケージファミリー製品について、DIE(チップ)とPowerPad(リードフレーム)間の接着材に、現行チップ接着剤 HN408xを使用しておりますが、熱伝導性の向上を目的として、これに変わり チップ接着剤 QMI529に変更し認定いたしました。この変更については、下記ピン/パッケージのPowerPad製品が対象の予定です。

変更内容	現行	変更後
チップ接着剤	HN408x	QMI529

PowerPad 製品			
Package	Pin	Package	Pin
DCA	48, 56	PHP	48
DCP	38, 44	PJD	64
DDV	44	PJW	64
DFD	56	PNP	128
DWD	20	PWD	24
DWP	20	PWP	14, 16, 20, 24, 28
PAP	64	PZP	100
PFD	100	RCP	64
PFP	80	VFP	32
PHD	64		

また、弊社認定試験の結果を基に対象製品の追加を今後予定しておりパッケージピン数などの組合せごとに認定結果を含め別途連絡させていただきます。

理由：熱伝導性の向上の為











日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

TAS5101IDAPG4	TPA3000D1APWPG4	TPS54353PWPR	TPS71H50QPWPG4	X1888CU2PWP
TAS5101IDAPR	TPA3000D1APWPR	TPS54353PWPRG4	TPS73HD301PWP	X1888CU36PWP
TAS5101IDAPRG4	TPA3000D1PWP	TPS54354PWP	TPS73HD301PWPR	X1888CU3PWP
TAS5110ADAD	TPA3000D1PWPR	TPS54354PWPG4	TPS73HD318PWP	XTLC5922DAP
TAS5110ADADR	TPA3001D1PWD	TPS54354PWPR	TPS73HD318PWPG4	XTLC5922DAPR
TAS5110DAD	TPA3001D1PWDR	TPS54354PWPRG4	TPS73HD318PWPR	XTLC5923DAP
TAS5110DADR	TPA3001D1PWP	TPS54355PWP	TPS73HD318PWPRG4	XTLC5923DAPR
TAS5110DAP	TPA3001D1PWPG4	TPS54355PWPG4	TPS73HD325PWP	XTLC5940PWP
TAS5110DAPR	TPA3001D1PWPR	TPS54355PWPR	TPS73HD325PWPG4	XTLC5940PWPR
TAS5110DAPRG4	TPA3001D1PWPRG4	TPS54355PWPRG4	TPS73HD325PWPR	XTPS2340PFP

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2006年8月21日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	6960BEA0PAPG4	DAC5675IPHP	SN105108PJP	THS8083APZP
Die Rev/Size(mils):	BE / 135x143	A / 125x139	F / 122x119	B / 224x225
Transistor Count:	--	10,000	--	--
Wafer Fab Site:	MIHO8	FFAB	HFAB	MIHO
Technology:	Bi-CMOS	RFBICMOS	Bi-CMOS	CMOS
Fab Process:	LBC6	RFBICMOS1	LBC4	33A12
Passivation:	6KHDP/14K PE-TEOS/10KACN	10KACN	--	--
Assembly Site:	PHI	TAI	TAI	TAI
Package / Pin Count:	PAP / 64	PHP / 48	PJP / 64	PZP / 100
Mold Compound:	SHI KMC3580HB	Shi KMC3580HB	Shi KMC3580HB	Shi KMC3580HB
Mount Compound:	Hen QMI529HT	Hen QMI529HT	Hen QMI529HT	Hen QMI529HT
Bond:	Au Ti-24.3um	TS -0.95mil Au	TS -1.3mils Au	TS -0.95mil Au
L/F Composition / Finish:	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu
Moist Sens Level:	Level 3-260C	Level 3-260C	Level 3-260C	Level 3-260C
BOAC/COA Type:	BOAC	None	BOAC	None
Qualification Device:	TLK1501IRCP	TNETD7103AVFP	TPA3004D2PHP	
Die Rev/Size(mils):	B / 98x103	J / 131x131	A / 181x181	
Wafer Fab Site:	ANAM	DFAB	DFAB	
Technology:	CMOS	Bi-CMOS	LBC	
Fab Process:	C10	BICOM2	LBC3	
Passivation:	--	--	10KACN	
Assembly Site:	TAI	TAI	TAI	
Package / Pin Count:	RCP / 64	VFP / 32	PHP / 48	
Mold Compound:	Shi KMC3580HB	Shi KMC3580HB	Shi KMC3580HB	
Mount Compound:	Hen QMI529HT	Hen QMI529HT	Hen QMI529HT	
Bond:	TS -0.95mil Au	TS -0.95mil Au	TS-1.15 Au	
L/F Composition / Finish:	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	
Moist Sens Level:	Level 3-260C	Level 2 -260C	Level 4-260C	
BOAC/COA Type:	None	None	BOAC	



信頼性試験結果 TLK1501IRCP				
Test Type	Condition/Duration	Lot -1	Lot -2	Lot -3
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0
Manufacturability	(per mfg. Site specification)	Pass	Pass	Pass
**Autoclave 121C	240 Hours	77/0	77/0	76/0
X-ray	(top side only)	Pass	Pass	Pass
**Temp Cycle, -65/150C	2000 cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock -65/150C	1000 cycles	77/0	77/0	77/0
**Storage Bake 170C	420 Hours	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	Level 3 - 260C, JEDEC	12/0		
Thermal Path Integrity, JEDEC	Level 3 - 260C	12/0		
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
** preconditioning sequence: JEDEC Level 3@260C				
TNETD7103AVFP				
Test Type	Condition/Duration	Lot -1	Lot -2	Lot -3
**Life Test, 140C	480 Hours	116/0	116/0	116/0
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0
Manufacturability	(per mfg. Site specification)	Pass	Pass	Pass
**HAST 130C/85% RH	96 Hours	78/0	78/0	78/0
**Autoclave 121C	240 Hours	77/0	77/0	77/0
X-ray	(top side only)	Pass	Pass	Pass
**Temp Cycle, -65/150C	2000 cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock -65/150C	1000 cycles	77/0	77/0	77/0
**Storage Bake 170C	420 Hours	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	Level 3 - 260C, JEDEC			12/0
Bond Strength	--	22/0	22/0	22/0
** preconditioning sequence: JEDEC Level 2@260C				
TPA3004D2PHP				
Test Type	Condition/Duration	Lot -1	Lot -2	Lot -3
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0
Manufacturability	(per mfg. Site specification)	Pass	Pass	Pass
**Autoclave 121C	240 Hours	77/0	77/0	77/0
X-ray	(top side only)	Pass	Pass	Pass
**Temp Cycle, -65/150C	2000 cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock -65/150C	1000 cycles	77/0	76/0	77/0
**Storage Bake 170C	420 Hours	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	Level 4 - 260C, JEDEC	12/0		
Thermal Path Integrity, JEDEC	Level 3 - 260C	12/0		
Bond Strength	--	22/0	22/0	22/0
** preconditioning sequence: JEDEC Level 4@260C				

## 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	—	終了
信頼性試験 – 試料構成詳細			
Qualification Device:	TAS5186ADDV	THS7530PWP	TPA1517DWP
Die Rev/Size(mils) :	A / 113x274	A / 71x54	D / 129x109
Wafer Fab Site:	DMOS5	FFAB	SFAB
Technology:	Bi-CMOS	Bi-CMOS	Bi-POLAR
Fab Process:	LBC5	BICOM3	J12
Assembly Site:	TAI	TAI	TAI
Package / Pin Count:	DDV / 44	PWP / 14	DWP / 20
Mold Compound:	Shi KMC3580HB	Shi KMC3580HB	Shi KMC3580HB
Mount Compound:	Hen QMI529HT	Hen QMI529HT	Hen QMI529HT
Bond:	TS -1.98mil Au	TS -0.95mil Au	TS -1.98mil Au
L/F Composition / Finish:	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu
Moist Sens Level:	Level 3-260C	Level 2-260C	Level 2-260C
BOAC/COA Type:	BOAC	None	None
Qualification Device:	TPS54010PWP	TPS54672PWP	TPS61030PWP
Die Rev/Size(mils) :	A / 84x250	A / 84x189	C / 84x79
Wafer Fab Site:	DFAB	DFAB	FFAB
Technology:	Bi-CMOS	Bi-CMOS	--
Fab Process:	LBC4	LBC4	A12
Assembly Site:	TAI	TAI	TAI
Package / Pin Count:	PWP / 28	PWP / 28	PWP / 16
Mold Compound:	Shi KMC3580HB	Shi KMC3580HB	Shi KMC3580HB
Mount Compound:	Hen QMI529HT	Hen QMI529HT	Hen QMI529HT
Bond:	TS -1.98mil Au	TS -1.98mil Au	TS -1.3mils Au
L/F Composition / Finish:	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu
Moist Sens Level:	Level 2-260C	Level 2-260C	Level 2-260C
BOAC/COA Type:	BOAC	BOAC	BOAC

信頼性試験結果				
TAS5186ADDV				
Test Type	Condition/Duration	Lot -1	Lot -2	Lot -3
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0
Manufacturability	(per mfg. Site specification)	Pass	Pass	Pass
**Autoclave 121C	240 hours	77/0	77/0	77/0
X-ray	(top side only)	Pass	Pass	Pass
**Temp Cycle , -65/150C	1000 cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock, -65/150C	1000 cycles	77/0	77/0	77/0
**Storage Bake, 170C	420 hours	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	Level 3-260C JEDEC	12/0		
Thermal Path Integrity, JEDEC	Level 3-260C	12/0		
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0

  

** preconditioning sequence: HIR Level 3@260C	THS7530PWP		
Test Type	Condition/Duration	Lot -1	
**Life Test, 125C	1000 hours	116/0	
Manufacturability	(per mfg. Site specification)	Pass	
**HAST 130C/85%RH	96 hours	77/0	
**Autoclave 121C	240 hours	76/0	
**Temp Cycle , -65/150C	2000 cycles	77/0	
**Thermal Shock, -65/150C	1000 cycles	77/0	
**Storage Bake, 150C	1000 hours	77/0	
Moisture Sensitivity	Level 1-260C, JEDEC	12/0	
Thermal Path Integrity, JEDEC	Level 1-260C	12/0	

